

概要

MAX1667は、任意の種類のバッテリを充電できる電力 制御機能を提供します。全ての充電機能がIntel社の システムマネジメントバス(SMBus™)インタフェースを 通じて制御されています。SMBus 2線シリアルインタ フェースは充電電圧及び電流を設定し、温度ステータス 情報を提供します。MAX1667は、Duracell/Intelスマート バッテリ充電器仕様に適合するレベル2充電器として 機能します。

MAX1667は、レベル2充電器に必要な機能の外にも、 充電器に電源が供給された時又はバッテリが着脱された 時に、割込を発生してホストに知らせることができます。 専用のステータスビットを使用して、充電器に十分な 入力電圧があるか、バッテリへの電圧又は電流が安定化 されているかをホストからチェックできます。このため、 ホストはバッテリに情報要求することなく、リチウム イオン(Li+)バッテリが完全に充電されたかどうかを判断 することができます。

MAX1667は、高さ2mmの20ピンSSOPで提供されて います。

アプリケーション

ノートブックコンピュータ 電子手帳

標準動作回路

充電器ベースステーション 電話

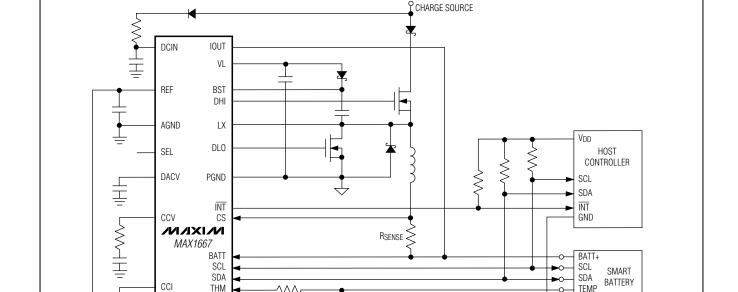
ピン配置はデータシートの最後に記載されています。

特長_

- ◆ あらゆるバッテリを充電: Li+、NiCd、NiMH、鉛等
- ◆ Intel SMBus 2線シリアルインタフェース
- ◆ Intel/Duracellレベル2スマートバッテリ規格 (Rev. 1.0)に適合
- ◆ 最大バッテリ充電電流: 4A、3A又は1A
- ◆ 充電電流を5ビットで制御
- ◆ バッテリ電圧:最大18.4V
- ◆ 電圧を11ビットで制御
- ◆ 電圧精度:±1%
- ◆ 最大入力電圧:+28V
- ◆ バッテリサーミスタ・フェイルセーフ保護
- ◆ 効率:95%以上
- ◆ 同期整流器

型番

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
MAX1667EAP	-40°C to +85°C	20 SSOP



SMBusはIntel Corp.の商標です。

BATT-

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

DCIN to AGND		PGND to AGND	
BST to AGND		SDA, INT Current	
BST, DHI to LX	0.3V to +6V	VL Current	50mA
LX, IOUT to AGND	0.3V to +30V	Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C)	
THM, CCI, CCV, DACV, REF,		SSOP (derate 8mW/°C above +70°C)	640mW
DLO to AGND	0.3V to (VL + 0.3V)	Operating Temperature Range	40°C to +85°C
VL, SEL, INT, SDA, SCL to AGND	0.3V to +6V	Storage Temperature Range	60°C to +150°C
BATT, CS+ to AGND	0.3V to +20V	Lead Temperature (soldering, 10sec)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $(V_{DCIN} = 18V, internal reference, 1\mu F capacitor at REF, 1\mu F capacitor at VL, T_A = 0^{\circ}C to +85^{\circ}C, unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25^{\circ}C, unless otherwise noted.)$

PARAMETER	CONE	CONDITIONS		TYP	MAX	UNITS
SUPPLY AND REFERENCE			'		'	
DCIN Input Voltage Range			7.5		28	V
DCIN Quiescent Current	7.5V < V _{DCIN} < 28V, log	gic inputs = VL		4	6	mA
VL Output Voltage	7.5V < V _{DCIN} < 28V, no	load	5.15	5.4	5.65	V
VL Load Regulation	I _{LOAD} = 0 to 10mA				100	mV
VL AC_PRESENT Trip Point			3.20	4	5.15	V
REF Output Voltage	0 < Isource < 500μA		4.055	4.096	4.137	V
SWITCHING REGULATOR						
Oscillator Frequency	Not in dropout		200	250	300	kHz
DHI Maximum Duty Cycle	In dropout		96.5	97.7		%
DHI On-Resistance	High or low			4	7	Ω
DLO On-Resistance	High or low			5	8	Ω
BATT Input Current (Note 1)	VL < 3.2V, V _{BATT} = 12V			1	5	μΑ
BATT Input Current (Note 1)	VL > 5.15V, V _{BATT} = 12	$VL > 5.15V$, $V_{BATT} = 12V$		350	500	μΑ
CS Input Current (Note 1)	VL < 3.2V, VCS = 12V			1	5	
C3 Input Guirent (Note 1)	S Input Current (Note 1) $\frac{VL > 5.15V, V_{CS} = 12V}{VL > 5.15V, V_{CS} = 12V}$			170	400	μΑ
BATT, CS Input Voltage Range			0		19	V
CS to BATT Single-Count Current-Sense Voltage	ChargingCurrent() = 0x	0080 (128mA)		5		mV
CS to BATT Full-Scale Current-Sense Voltage	SEL = VL (4A), ChargingCurrent() = 0xl	0F80 (3968mA)	145	160	175	mV
	ChargingVoltage() = 0x3130 (12,592mV)	T _A = +25°C	-0.8		0.8	
Voltage Accuracy	and 0x41A0 (16,800mV)	TA = TMIN to TMAX	-1.0		1.0	%
voltage hoodi acy	ChargingVoltage() = 0x1060 (4192mV)	T _A = +25°C	-1.0		1.0	/0
	and 0x20D0 (8400mV)	TA = TMIN to TMAX	-3.0		3.0	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{DCIN} = 18V, internal reference, 1\mu F capacitor at REF, 1\mu F capacitor at VL, T_A = 0°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25°C, unless otherwise noted.)$

PARAMETER		CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
ERROR AMPLIFIERS						
GMV Amplifier Transconductance				1.4		mA/V
GMI Amplifier Transconductance				0.2		mA/V
GMV Amplifier Maximum Output Current				±80		μΑ
GMI Amplifier Maximum Output Current				±200		μА
CCV Clamp Voltage with Respect to CCI	1.1V < V _{CCI} < 3.	5V	25	80	200	mV
CCI Clamp Voltage with Respect to CCV	1.1V < V _{CCV} < 3	1.1V < V _{CCV} < 3.5V		80	200	mV
TRIP POINTS AND LINEAR CURREN	T SOURCES					
BATT POWER_FAIL Threshold	BATT rising		93	95	97	% of VDCIN
BATT POWER_FAIL Threshold Hysteresis				1		% of V _{DCIN}
THM THERMISTOR_OR Overrange Trip Point	THM falling		89	91	93	% of V _{REF}
THM THERMISTOR_COLD Trip Point	THM falling	THM falling		75.5	77	% of V _{REF}
THM THERMISTOR_HOT Trip Point	THM falling	THM falling		23.5	25	% of V _{REF}
THM THERMISTOR_UR Underrange Trip Point	THM falling		3	4.5	6	% of VREF
THM THERMISTOR_OR, _COLD, _HOT, _UR Trip Point Hysteresis				0.5		% of VDCIN
	V _{IOUT} = 0	ChargingCurrent() = 0x0001 to 0x007F (127mA)	5	7	9	mA
IOUT Output Current		ChargingCurrent() = 0x0000			10	μΑ
	V _{IOUT} = 17V, Ch to 0x007F (127m	argingCurrent() = 0x0001 A)	5			mA
IOUT Leakage Current	V _{DCIN} = 0, V _{IOUT} = 20V				10	μΑ
CURRENT- AND VOLTAGE-SETTING	DACs					
CDAC Current-Setting DAC Resolution	Guaranteed mon	otonic	5			Bits
VDAC Voltage-Setting DAC Resolution	Guaranteed mon	otonic	11			Bits
LOGIC LEVELS						
SDA, SCL Input Voltage Low					0.8	V
SDA, SCL Input Voltage High			2.2			V
SDA, SCL Input Bias Current			-1		1	μΑ
SDA Output Low Sink Current	V _{SDA} = 0.6V		6			mA

Note 1: When DCIN is less than 4V, VL is less than 3.2V, causing the battery current to be typically 2μA (CS plus BATT input current).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $(V_{DCIN} = 18V, internal reference, 1\mu F capacitor at REF, 1\mu F capacitor at VL, T_A = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25°C. Limits over this temperature range are guaranteed by design.)$

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	
SUPPLY AND REFERENCE	·	<u>'</u>				
DCIN Quiescent Current	7.5V < VDCIN < 28V, logic inputs = VL		4	6	mA	
VL Output Voltage	7.5V < V _{DCIN} < 28V, no load	5.15	5.4	5.65	V	
REF Output Voltage	0 < ISOURCE < 500μA	4.055		4.137	V	
SWITCHING REGULATOR	,	'				
Oscillator Frequency	Not in dropout	200	250	310	kHz	
DHI Maximum Duty Cycle	In dropout	96.5			%	
DHI On-Resistance	High or low		4	7	Ω	
DLO On-Resistance	High or low		5	8	Ω	
BATT Input Current (Note 1)	VL < 3.2V, V _{BATT} = 12V			5	μΑ	
CS Input Current (Note 1)	VL < 3.2V, V _{CS} = 12V			5	μΑ	
CS to BATT Full-Scale Current-Sense Voltage	V _{SEL} = VL, ChargingCurrent() = 0x0F80 (128mA)	145	160	175	mV	
W. II.	ChargingVoltage() = 0x3130 (12,592mV), ChargingVoltage() = 0x41A0 (16,800mV)	-1.0	1.0		2/	
Voltage Accuracy	ChargingVoltage() = 0x1060 (4192mV), ChargingVoltage() = 0x20D0 (8400mV)	-3.0		3.0	%	
TRIP POINTS AND LINEAR CURRE	NT SOURCES					
THM THERMISTOR_OR Overrange Trip Point	THM falling	88.5		93.5	% of V _{REF}	
THM THERMISTOR_COLD Trip Point	THM falling	73.5		77.5	% of V _{REF}	
THM THERMISTOR_HOT Trip Point	THM falling	21.5		25.5	% of V _{REF}	
THM THERMISTOR_UR Underrange Trip Point	THM falling	2.5		6.5	% of VREF	
THM THERMISTOR_OR, _COLD, _HOT, _UR Trip Point Hysteresis			1		%	
LOGIC LEVELS						
SDA, SCL Input Voltage Low				0.5	V	
SDA, SCL Input Voltage High		2.2			V	
SDA, SCL Input Bias Current		-1		1	μΑ	
SDA Output Low Sink Current	VSDA = 0.6V	6			mA	

TIMING CHARACTERISTICS (Figures 1 and 2)

(T_A = 0°C to +85°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SCL Serial-Clock High Period	thigh		4			μs
SCL Serial-Clock Low Period	tLOW		4.7			μs
Start-Condition Setup Time	tsu:sta		4.7			μs
Start-Condition Hold Time	thd:Sta		4			μs
SDA Valid to SCL Rising-Edge Setup Time, Slave Clocking in Data	tsu:DAT		250			ns
SCL Falling Edge to SDA Transition	thd:dat		0			ns
SCL Falling Edge to SDA Valid, Master Clocking in Data	t _{DV}				1	μs

TIMING CHARACTERISTICS (Figures 1 and 2)

(T_A = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Limits over this temperature range are guaranteed by design.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SCL Serial-Clock High Period	tHIGH		4			μs
SCL Serial-Clock Low Period	tLOW		4.7			μs
Start-Condition Setup Time	tsu:sta		4.7			μs
Start-Condition Hold Time	thd:sta		4			μs
SDA Valid to SCL Rising-Edge Setup Time, Slave Clocking in Data	tsu:DAT		250			ns
SCL Falling Edge to SDA Transition	thd:dat		0			ns
SCL Falling Edge to SDA Valid, Master Clocking in Data	t _{DV}				1	μs

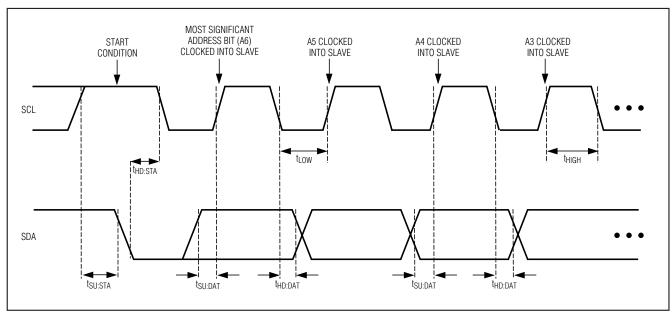


図1. SMBusシリアルインタフェータイミング: アドレス

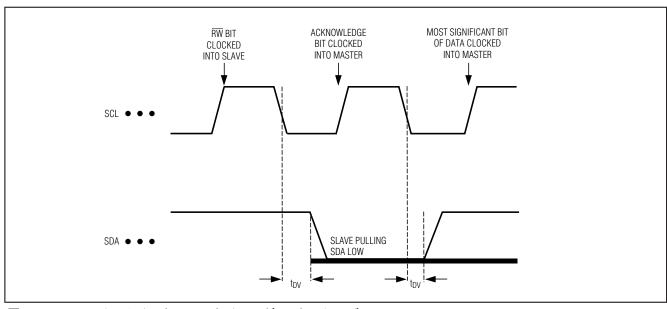
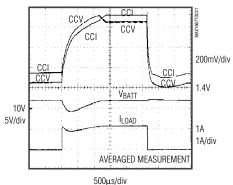


図2. SMBusシリアルインタフェータイミング: アクノレッジ

標準動作特性

((Circuit of Figure 7, T_A = +25°C, unless otherwise noted.)

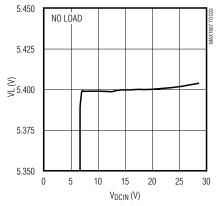
LOAD TRANSIENT (VOLTAGE REGULATION WITH CURRENT LIMIT)



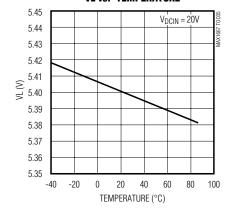
 $V_{DCIN} = 18V$ ChargingVoltage() = 12,000mV

ChargingCurrent() = 1500mA

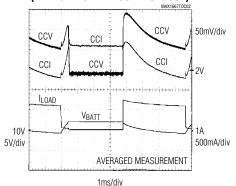
VL LINE REGULATION



VL vs. TEMPERATURE



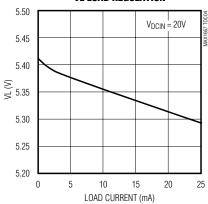
LOAD TRANSIENT (WITH CHANGE IN REGULATION LOOP)



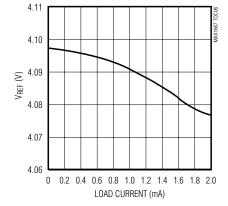
 $V_{DCIN} = 18V$

ChargingVoltage() = 12,000mV ChargingCurrent() = 1500mA

VL LOAD REGULATION

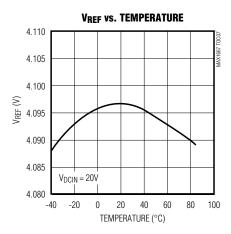


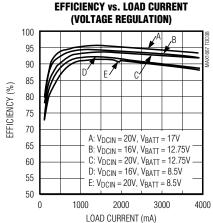
VREF LOAD REGULATION

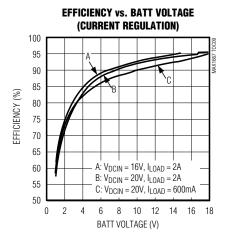


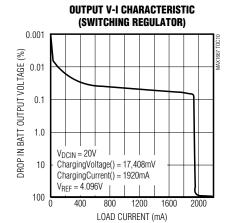
標準動作特性(続き)_

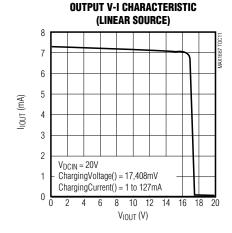
(Circuit of Figure 7, $T_A = +25$ °C, unless otherwise noted.)

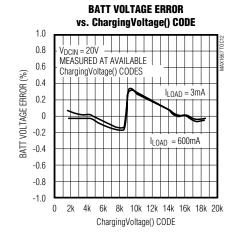


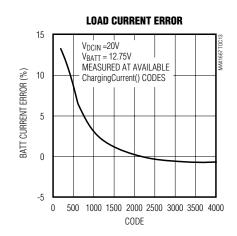












端子説明 ______

端子	名称	機能
1	IOUT	リニア電流ソース出力
2	DCIN	充電器駆動用入力電圧
3	VL	IC電源。DCINからの5.4Vリニアレギュレータ出力。
4	CCV	電圧レギュレーションループ補償ポイント
5	CCI	電流レギュレーションループ補償ポイント
6	SEL	電流範囲セレクタ。SELをVLに接続するとフルスケール電流が4A、SELをオープンにするとフルスケール電流が3A、SELをAGNDに接続するとフルスケール電流が1Aになります。
7	CS	電流検出正入力
8	BATT	バッテリ電圧入力及び電流検出負入力
9	REF	+4.096Vリファレンス電圧出力又は外部リファレンス入力
10	AGND	アナロググランド
11	ĪNT	オープンドレイン割込出力
12	THM	サーミスタ検出電圧入力
13	SCL	シリアルクロック(外部プルアップ抵抗が必要)
14	SDA	シリアルデータ(外部プルアップ抵抗が必要)
15	DACV	電圧DAC出力フィルタリングポイント
16	PGND	電源グランド
17	DLO	ローサイドパワーMOSFETドライバ出力
18	DHI	ハイサイドパワーMOSFETドライバ出力
19	LX	ハイサイドパワーMOSFETドライバの電源接続
20	BST	ハイサイドパワーMOSFETドライバの電源接続

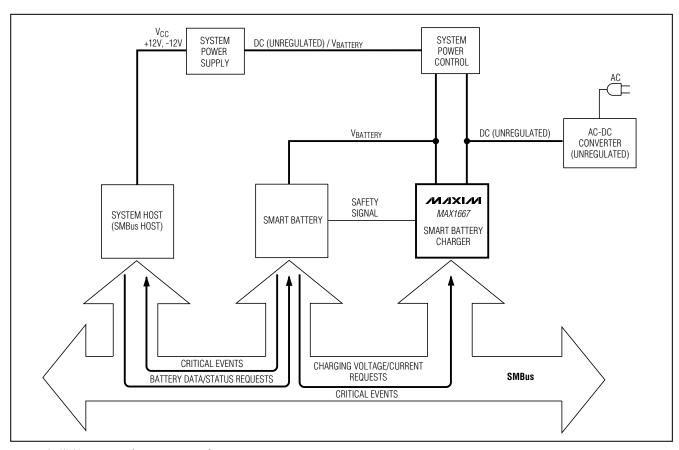


図3. 標準的なシングルスマートバッテリシステム

スマートバッテリ充電システム

最も単純な構成のスマートバッテリ充電システムは、スマートバッテリ及びIntel社のシステムマネジメントバス(SMBus)を採用したスマートバッテリシステム規格とコンパチブルなスマートバッテリ充電器からなっています。

スマートバッテリシステムのブロック図

1つのシステムに1つ以上のスマートバッテリを使用できます。図3に示すスマートバッテリ充電システムではシングルバッテリシステムになっています。これはノートブックコンピュータ、ビデオカメラ、携帯電話及びその他のポータブル電子機器で通常見られる形です。

2つ以上のスマートバッテリを使用したシステムも可能です。複数のバッテリを使用したシステムのダイアグラムを図4に示します。バッテリをスマートバッテリ充電器又はシステムに接続するか、切り離すためにスマートバッテリセレクタを使用できます。標準的なスマートバッテリの場合、電源(バッテリの正及び

負端子)、SMBus(クロック及びデータ)及び安全信号 (抵抗、通常は温度に依存)を接続する必要があります。 さらにシステムホストがシステム内の全てののバッテリ の状態を表示できるように、システム内の任意のバッテリにクエリーできることが必要です。

図4は、2バッテリシステムでバッテリ2が充電中で、バッテリ1がシステムを駆動している場合を示しています。この構成はバッテリ1をコンディショニングして、充電の前に完全放電するために使用できます。

スマートバッテリ充電器のタイプ

レベル2及びレベル3という、2つのタイプのスマート バッテリ充電器が定義されています。全てのスマート バッテリ充電器はSMBusを使ってスマートバッテリと 通信します。この2つのタイプは、SMBus通信モード が異なり、またスマートバッテリの充電アルゴリズム を修正するかどうかどうかが異なっています(表1参照)。 レベル3スマートバッテリ充電器はレベル2充電器の スーパーセットになっているため、レベル2充電器の 全てのコマンドをサポートします。

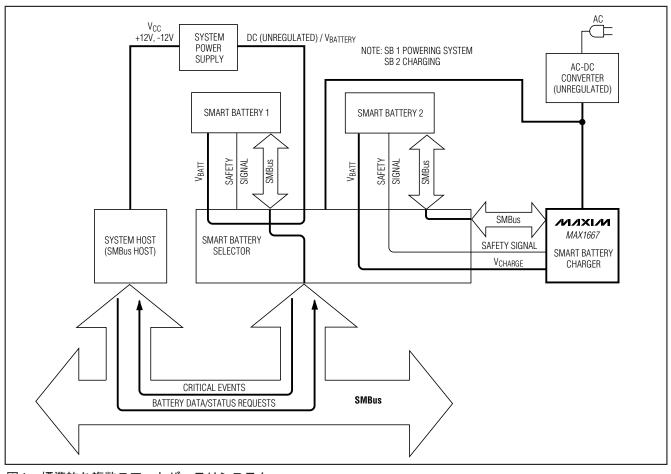


図4. 標準的な複数スマートバッテリシステム

表1. SMBusモード及び充電アルゴリズム ソースによる充電器のタイプ分け

SMBus MODE	CHARGE ALG	ORITHM SOURCE
SWIDUS WIODL	Battery	Modified from Battery
Slave Only	Level 2	Level 3
Slave/Master	Level 3	Level 3

注記:レベル1スマートバッテリ充電器は、バージョン0.95a 規格で定義されています。これらの充電器は、SMBusの充電完了メッセージを正しく解釈して過充電を最小限にすることができますが、真にあらゆるバッテリ種に対応する充電はできません。スマートバッテリ充電器規格ではもうこれらの充電器を定義しておらず、これらは本規格及び将来のスマートバッテリ充電器規格には適合しないことが明示されています。

レベル2スマートバッテリ充電器

レベル2(「スマートバッテリ制御」スマートバッテリ 充電器)はスマートバッテリの重要な警報メッセージを 解釈し、スマートバッテリから送ってくるCharging Voltage()及びChargingCurrent()メッセージに応答する SMBusスレーブデバイスとして動作します。充電器は、 バッテリから受け取ったメッセージに直接従属的に応答 して、それ自身の出力特性を調節します。レベル2充電 においては、通信を開始して充電アルゴリズムを充電器 に提供する役目はスマートバッテリが全面的に担って います。スマートバッテリはそれ自身に対してどのよう な充電が最適であるかを一番よく知っています。バッ テリ内の充電アルゴリズムは静的な充電条件を要求する 場合も、その時の必要性に合せて定期的にスマートバッ テリ充電器の出力を調節する場合もあります。レベル2 スマートバッテリ充電器は、真にあらゆるバッテリ種 に対応しています。また、スマートバッテリスレーブ デバイスのみとして定義されているために比較的安価 で使いやすくなっています。

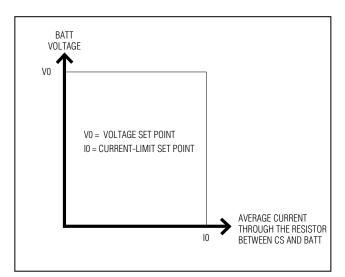


図5. 出力V-I特性

詳細 ___

出力特性

MAX1667は、電圧レギュレーションループ及び電流レギュレーションループの両方を備えています。これらのループは、互いに独立して動作します。電圧レギュレーションループはBATTを監視して、電圧が電圧設定値(V0)を決して超えないようにします。電流レギュレーションループはBATTに供給される電流を監視して、この電流が電流リミット設定点(I0)を決して超えないようにします。BATT電圧がV0よりも低い間は、電流レギュレーションループによって支配されます。BATT電圧がV0に達すると、電流ループによりレギュレーションが停止され、電圧レギュレーションループが取って代わります。図5に、BATTピンのV-I特性を示します。

V0及びI0の設定

MAX1667の電圧及び電流リミット設定点は、Intel SMBus 2線シリアルインタフェースを使用して設定して下さい。MAX1667のロジックは、SMBusインタフェースからのシリアルデータストリームを解釈して内部ディジタルアナログコンバータ(DAC)を適切に設定します。V0と10のパワーオンリセット値はそれぞれ18.4V及び7mAです。詳細については「ディジタル部」を参照して下さい。

アナログ部

MAX1667のアナログ部は、電流モードパルス幅変調 (PWM)コントローラ及び2つのトランスコンダクタンスエラーアンプ(電流レギュレーション用と電圧レギュレーション用)から構成されています。 MAX1667は、電流と電圧レベルを設定するためにDACを利用しています。これらのDACは、SMBusインタフェースを通じて制御

されています。電圧と電流の制御に独立のアンプを使用しているため、いずれの制御ループも各々の状態における最適の安定性と応答を得るために個別に補償できます。

MAX1667が任意の時点で電圧を制御しているか電流を制御しているかは、バッテリの状態に依存します。バッテリが放電された状態の場合は、MAX1667の出力が電圧リミットよりも前に電流レギュレーションが行われます。バッテリが充電されてくると電圧が上昇して電圧リミットに達し、充電器はその時点で電圧レギュレーションに移行します。電流レギュレーションから電圧レギュレーションへの遷移は充電器によって行われるため、ホストによる制御の必要はありません。図6にMAX1667のブロック図を示します。

電圧制御

内部GMVアンプがMAX1667の出力電圧を制御します。アンプの非反転入力における電圧は、11ビットDACによって設定されます。一方このDACは、SMBusのChargingVoltage()コマンドによって制御されます(詳細については「ディジタル部」を参照)。バッテリ電圧は、5:1の抵抗分圧器を通じてGMVアンプに供給されます。設定電圧は0~18.416V(分解能は16mV)の範囲になります。これにより、最大4つの直列Li+セルを充電できます。

GMVアンプの出力は、CCVピンに接続されています。このピンは、電圧レギュレーションループを補償します。通常、直列抵抗/コンデンサの組み合わせを使用して、ポール・ゼロ・ダブレットを形成できます。ここで導入されたポールにより、利得は低周波数でロールオフし始めます。このダブレットのゼロは、中周波数で十分なAC利得を提供します。次に、出力コンデンサが中周波数利得を1以下にロールオフすることにより、出力コンデンサの等価直列抵抗(ESR)によって導入されたゼロに出会う前に安定性を保証します。GMVアンプの出力は、内部でREFの電圧の1/4~1/3の間にクランプされています。

電流制御

内部リニア電流ソースとPWMレギュレータは、バッテリ充電電流を制御します。電流が0に設定されていると、電圧レギュレータはオンになっていても電流を供給できません。電流設定が1mA~127mAの時にリニア電流ソースがターンオンして、トリクル充電用として最大7mAを供給します。電流設定が127mA以上の場合、リニア電流ソースはディセーブルされ、充電電流は5ビット電流制御DACで設定されたスイッチングレギュレータによって提供されます。

GMIアンプの非反転入力は4:1抵抗電圧分圧器によって 駆動され、この分圧器は5ビットDACによって駆動され

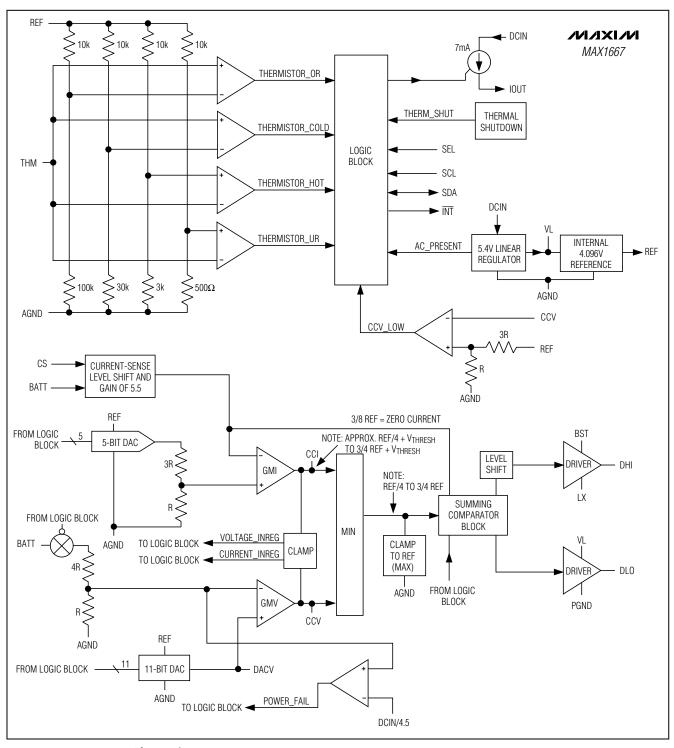


図6. ファンクションダイアグラム

ます。内部リファレンスは4.096Vであるため、この 入力はフルスケールが約1.0V、分解能が31mVです。 電流検出アンプにより、GMIアンプの反転入力が駆動 されます。これは電流検出抵抗(R_{SFN})の両端の電圧(CS とBATTピンの間)を測定し、それを約5.45倍に増幅し、 グランドにレベルシフトします。フルスケール電流は 約0.16V/R_{SFN}で、分解能は5mV/R_{SFN}となっています。 電流レギュレーションループは、CCIピンにコンデンサ を付加することにより補償されます。このコンデンサに より、電流フィードバックループの主ポールが設定され ます。GMIアンプの出力は、REFの電圧の1/4~1/3の 間にクランプされています。電流が安定化状態にある 場合、CCV電圧はCCI電圧から80mV以内にクランプ されます。このようにして、DAC電圧設定の更新時に バッテリ電圧がオーバーシュートするのを防ぎます。 電圧が安定化状態で電流が電流DAC設定から外れて いる時は、この逆が成り立ちます。CCI又はCCVの直線 範囲は約1.5V~3.5V(つまり約2V)であるため、クランプ が80mVであれば、ループが電圧と電流の間で切り替わ るときのオーバーシュートはほぼ無視できます。

PWMコントローラ

バッテリ電圧又は電流は、電流モード、PWM DC-DCコンバータコントローラによって制御されます。このコントローラにより、2つの外部NチャネルMOSFETが駆動されます。これらのMOSFETが入力ソースからの電圧をスイッチングします。スイッチングされたこの電圧がインダクタに供給され、インダクタはスイッチングされた矩形波をフィルタリングします。このコントローラは、スイッチングされた電圧のパルス幅を設定することによって、希望の電圧又は電流をバッテリに供給します。

PWMコントローラの心臓部は、複数入力コンパレータです。このコンパレータは、3つの入力信号の総和を求めてスイッチングされた信号のパルス幅を決め、それによってバッテリ電圧又は電流を設定します。この3つの信号は、電流検出アンプの出力、GMV又はGMIエラーアンプの出力及びスロープ補償信号(コントローラの内部電流制御ループの安定性を保証)です。

PWMコンパレータは、電流検出アンプの出力をGMVアンプ又はGMIアンプのどちらか低い方の出力電圧(エラー電圧)と比較します。この電流モードフィードバックは、スイッチングされた電圧のデューティレシオを修正し、これによりピークバッテリ電流を調節してます。平均バッテリ電流はピーク電流にほぼ等しいため、コントローラはトランスコンダクタンスアンプとして作動し、インダクタが出力インダクタとバッテリの寄生容量によって形成される出力フィルタにに及ぼす影響を低減します。これにより、出力フィルタが複雑な二次RLCから一次RCに変わるため、回路を安定させるのが容易になります。内部電流制御ループの安定性を維持するため、ます。内部電流制御ループの安定性を維持するため、

スロープ補償信号もコンパレータに供給されます。これにより、デューティレシオが50%以上の時のパルス幅の不安定性を抑えます。

重負荷時におけるPWMコントローラは、固定周波数でスイッチングし、デューティサイクルを変調することによりバッテリ電圧又は電流を制御します。軽負荷時にインダクタを流れる電流は、電流が同期整流器を通じて負になるのを防ぐには十分ではありません(図7、M2)。コントローラは、検出抵抗R_{SEN}を通じて電流を監視します。電流がゼロに落ちると、同期整流器がターンオフして負の電流が流れないようにします。

MOSFETドライバ

MAX1667は、外部NチャネルMOSFETドライバを駆動してバッテリ電圧又は電流のレギュレーションを行います。ハイサイドNチャネルMOSFETのゲートは、入力ソース電圧よりも高い電圧まで駆動されなければならないため、この電圧を発生するためにチャージポンプが使用されます。同期整流器がターンオンすると、コンデンサC7(図7)はD2を通じて約5Vまで充電されます。C7の片側はLXピン(M1のソース)に接続されているため、ハイサイドMOSFETがターンオンするとハイサイドドライバ(DHI)はBSTの電圧までゲートを駆動できます(BSTは、入力電圧よりも高くなっています)。

同期整流器がオンの間にBSTコンデンサを充電するため、ダイオードが完全に同期整流器に取って代わることはできません。同期整流器がないとBSTコンデンサが完全に充電されず、ハイサイドMOSFETがターンオンするために十分なゲート駆動電圧が得られない可能性があります。しかし、BSTを確実に充電するために、同期整流器を小さなMOSFET(2N7002等)で置き換えることはできます。この場合、大電流時の電流の殆どは同期整流器ではなくショットキダイオードを通ります。

内部レギュレータ及びリファレンス

MAX1667は、内部低ドロップアウトリニアレギュレータを使用して5.4V電源(VL)を生成し、この電源がICの内部回路を駆動します。VLによって、最大20mAまでの電流を供給することができます。このうち10mA弱が内部回路を駆動するために使用されますが、残りの電流は外部回路を駆動するために使用できます。MOSFETを駆動する電流はこの電源から与えられます。このため、引き出せる電力の算出にはこのことを考慮する必要があります。MOSFETを駆動するために必要な電流を計算するには、各MOSFETの全ゲートチャージにスイッチング周波数(標準250kHz)を掛けて下さい。VLの安定性を確保するため、VLピンを1μF以上のコンデンサでバイパスして下さい。

MAX1667は、高精度4.096Vリファレンス電圧を内蔵しています。これにより電圧設定精度 $\pm 1\%$ (max)が保証されます。リファレンスは、 1μ F以上のコンデンサでバイパスして下さい。

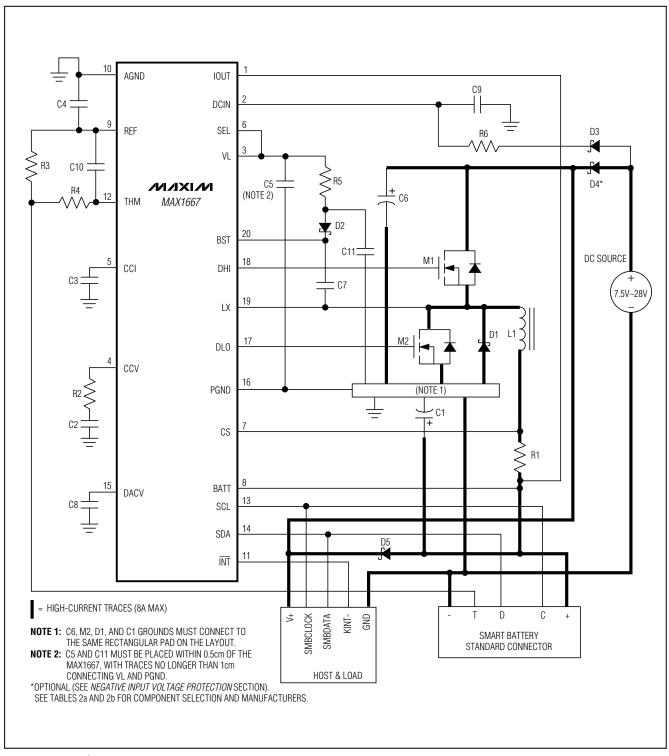


図7. 標準アプリケーション回路

表2a. 部品の選択

DESIGNATION	MANUFACTURER	1A	3A	4A	
0.1			68μF, 20V, low ESR		
C1 Output Capacitor	AVX		TPSE686M020R0150		
Output Capacitor	Sprague	594D686X0025R2T			
C2, C7, C11		0.1μF			
C3			47nF		
C4, C5, C9, C10			1µF		
00			2 x 22µF, 35V, low ESR		
C6 Input Capacitor	AVX		TPSE226M035R0200		
приг Оараспо	Sprague		594D226X0035R2T		
C8			22nF		
		1N5819 equivalent	1N5821 equivalent	1N5821 equivalent	
D1, D4, D5	Motorola	MBRS130LT3	MBRS340T3	MBRS340T3	
Schottky Diodes	Central		CMSH3-40	CMSH5-40	
	NIEC	EC31	NSQ03A04	CMSH5-40	
D2, D3	Central	Schottky diode, 50mA I _{DC} , 30V, CMPSH-3			
		33µH, 1A ISAT	33µH, 3A ISAT, 30V	33µH, 4A ISAT, 30V	
L1	Sumida	CDH74-330	CDRH127-330	CDRH127-270	
Inductor	Coiltronics	UP1B-330	UP3B-330		
	Coilcraft	DS3316P-333			
	IR	IRF7603	IRF7201	IRF7805	
M1 High-Side MOSFET	Fairchild	FDN359A	FDS4410	FDS6680	
riigir olde Moor Er	Motorola	MTSF3N03HD	MMDF3N03HD		
M2		2N7002 equivalent			
Low-Side MOSFET	Motorola		MMBF1170LT1		
R1			$40m\Omega \pm 1\%$, $1W$		
Sense Resistor	IRC	LR251201R040F			
Dale			WSL-2512/0.04W/±1%		
R2, R4		10kΩ ±5%, 1/16W			
R3			10kΩ ±1%, 1/16W		
R5, R6			33Ω ±5%, 1/16W		

ディ	ィジタ	ル部	

SMBusインタフェース

MAX1667は、シリアルデータを使用して動作を制御します。シリアルインタフェースは、SMBus規格に適合しています。www.sbs-Forum.org又はIntel Archictecture Labs:800-253-3696からSystem Management Bus Specificationを入手して参照して下さい。充電器の機能は、Intel/Duracellスマート充電器規格のレベル2充電器に適合しています。

MAX1667は、SMBus Read-Word及びWrite-Word プロトコルを使用して充電するバッテリ及び(該当する 場合は)バッテリから充電器への通信を監視するホスト システムと通信します。MAX1667はスレーブデバイス としてだけ機能するため、バス上で自ら通信を開始することはなく、コマンドを受け取ってステータス情報の質問に応答するだけとなっています。図8a及び図8bに、SMBus Write-Word及びRead-Wordプロトコルの例を示します。

MAX1667との各通信は、SCLがハイの時のSDAの立下がリエッジとして定義されるスタート状態をマスターが発信することによって開始されます(図1)。

スレーブとの通信が完了すると、マスターはSTOP状態を発信します。これはSCLがハイの状態でSDAがローからハイに遷移することです。これでバスを別の伝送に使用することができるようになります。図1と図2にSMBusインタフェース上の信号のタイミング図を示します。アドレスバイト、制御バイト及びデータバイト

表2b. 部品メーカ

MANUFACTURER	PHONE	FAX
AVX	803-946-0690	803-626-3123
Central Semiconductor	516-435-1110	516-435-1824
Coilcraft	847-639-6400	847-639-1469
Coiltronics	561-241-7876	561-241-9339
Dale	605-668-4131	605-665-1627
IR	310-322-3331	310-322-3332
IRC	512-992-7900	512-992-3377
NIEC	805-867-2555	805-867-2698
Siliconix	408-988-8000	408-970-3950
Sprague	603-224-1961	603-224-1430
Sumida	847-956-0666	847-956-0702
Zetex	516-543-7100	516-864-7630

はSTART状態とSTOP状態の間に送信されます。データは8ビットワードで送信され、各バイトの後でスレーブ又はマスターがアクノレッジを送信します(図2)。このため、各バイトを転送するのに9クロックサイクルを必要とします。START状態とSTOP状態を除き、SDA状態の変化が許容されるのはSCLがローの場合のみです。

MAX1667の7ビットアドレスは、0b0001001にプリセットされています。8番目のビットはWrite-Word (\overline{W} = 0)又はRead-Word(R = 1)コマンドを示します。これはWrite-Wordコマンドの場合16進数の0x12、Read-Wordコマンドの場合16進数の0x13で表すこともできます。

以下のコマンドはWrite-Wordプロトコルを使用します (図8a): ChargerMode()、ChargingVoltage()、ChargingCurrent()及びAlarmWarning()。ChargeStatus コマンドはRead-Wordプロトコルを使用します(図8b)。

ChargeMode()

ChargeMode()コマンドは、Write-Wordプロトコルを使用します(図8a)。ChargeMode()のコマンドコードは0x12(0b00010010)です。表3に、16個のデータビット(D0~D15)の機能が説明されています。ビット0は、Write-WordプロトコルのD0ビットを表します。

ChargerStatus()のBATTERY_PRESENT状態ビット (ビット14)がクリアの時は、その前のChargeMode() コマンドが何であってもHOT_STOPビットがセットされます。充電されるバッテリのサーミスタインピーダンスがHOT範囲(つまり、THERMISTOR_HOT = 1及びTHERMISTOR_UR = 0)にある場合、バッテリが挿入された後でホストがChargeMode()コマンドを使用してHOT_STOPをクリアする必要があります。HOT_STOPビットは、バッテリを外すとデフォルトパワーアップ状態(1)に戻ります。

ChargingVoltage()

ChargingVoltage()コマンドは、Write-Wordプロトコルを使用します(図8a)。ChargingVoltage()のコマンドコードは0x15 (0b00010101)です。D15~D0が形成する16ビットバイナリ数は、電圧設定点(V0)をミリボルト単位で表します。但し、MAX1667がV0を設定する際の分解能は16mVしかないため、D0、D1、D2及びD3ビットは無視されます。

MAX1667が供給する最大の電圧は18.416Vで、これはChargingVoltage()の値として0x47F0に対応します。これは、パワーオンリセット(POR)によって設定されるフローティング電圧設定でもあります。ChargingVoltage()の値が0x47F0を超える場合は、フローティング電圧が供給され、VOLTAGE_OR状態ビットがセットされます。BATTERY_PRESENT状態ビットがクリアされると、ChargingVoltage()レジスタがPOR状態に戻ります。

図9に、V0(電圧レギュレーションループの設定ポイント) とChargingVoltage()の間のマッピングを示します。

ChargingCurrent()

ChargingCurrent()コマンドは、Write-Wordプロトコルを使用します(図8a)。ChargingCurrent()のコマンドコードは0x14 (0b00010100)です。D15~D0が形成する16ビットバイナリ数は、電流リミット設定点(I0)をミリアンペア単位で設定します(表4)。SELをAGNDに接続すると、I0の最大設定値が0.896Aになります。SELをオープンにすると、I0の最大設定値が2.944Aになります。SELをVLに接続すると、I0の最大設定値が3.968Aになります。

MAX1667の中の2つの電流ソースによってバッテリが充電されます。即ち、リニア電流ソースがIOUTから出力し、スイッチングレギュレータが電流検出抵抗(R1)を流れる電流を制御します。IOUTは、バッテリの自己放電を補償するための小さなトリクル充電電流を供給し、スイッチングレギュレータは急速充電用の大電流を供給します。

IOUTは、7mAの電流のソースとなり、スイッチングレギュレータは $128mA \sim 3968mA$ の電流ソースになります(分解能は5ビットで、検出抵抗が40m の場合LSB = 5.12mV/RSENSE = 128mA)となります。表4において、DA4 \sim DA0は電流DACコードのビットを表しています。表5に、ChargingCurrent()コマンドでプログラムされた値とIOUTソース電流との間の関係を示します。CCV_LOWコンパレータはCCVをREF/4と比較することによって、出力電圧が高すぎるかどうかをチェックします。CCV_LOW = 1(CCV < REF/4の時)の場合、IOUTは停止して、出力電圧がCharging Voltage()レジスタで指定された電圧設定点を超えるの

表3. ChargeMode()ビットの機能

BIT NAME	BIT POSITION*	POR VALUE**	FUNCTION
INHIBIT_CHARGE	0 (LSB)	0	0 = Allow normal operation; clear the CHG_INHIBITED status bit. 1 = Turn the charger off; set the CHG_INHIBITED status bit.
ENABLE_POLLING	1	_	Not implemented. Write 0 into this bit.
POR_RESET	2	_	0 = No change in any non-ChargerMode() settings. 1 = Change the voltage and current settings to 0xFFFF and 0x0007 respectively; clear the THERMISTOR_HOT and ALARM_INHIBITED bits.
RESET_TO_ZERO	3	_	Not implemented. Write 0 into this bit.
N/A	4	_	Not implemented. Write 1 into this bit.
BATTERY_PRESENT_MASK	5	0	0 = Interrupt on either edge of the BATTERY_PRESENT status bit. 1 = Do not interrupt because of a BATTERY_PRESENT bit change.
POWER_FAIL_MASK	6	1	0 = Interrupt on either edge of the POWER_FAIL status bit. 1 = Do not interrupt because of a POWER_FAIL bit change.
N/A	7–9	_	Not implemented. Write 1 into this bit.
HOT_STOP	10	1	0 = The THERMISTOR_HOT status bit does not turn the charger off. 1 = THERMISTOR_HOT turns the charger off.
N/A	11-15 (MSB)	_	Not implemented. Write 1 into this bit.

*D15~D0データ中のビット位置。 **パワーオンリセット値。 N/A = 使用不能。

を防ぎます。内部クランプがCCVを引き下げると常に VOLTAGE_NOTREG = 1となります(内部クランプが CCVを引き下げるのは、この電圧をCCIの電圧の近くに 留めるためです)。

スイッチングレギュレータがオンの時のR1を流れる電流(図7)のレギュレーションは、CSとBATTの間の平均電圧を検出することによって行われます。図10に、ChargingCurrent()とCSとBATTの間の平均電圧の関係を示します。

スイッチングレギュレータがオフの時には、DHIが強制的にLXになり、DLOは強制的にグランドになります。これにより、インダクタL1に電流が流れなくなります。表6に、ChargingCurrent()レジスタの値とスイッチングレギュレータ電流DACコードの関係を示します(DA4~DA0)。

R1を40m にできるだけ近くして、実際の出力電流をChargingCurrent()コマンドでプログラムされたデータ値に一致させて下さい。SELピンの設定はフルスケール電流に影響しますが、ステップサイズには影響しません。ChargingCurrent()値がフルスケール設定値を超えると、CURRENT_OR状態ビットがセットされます。電流DACビットのどれかが設定されるとリニア電流ソースはターンオフされることに注意して下さい。

ChargingCurrent()レジスタのパワーオンリセット値は、0x0007です。BATTER_PRESENT状態ビットがクリア(バッテリが外された状態)の時には、Charging Current()レジスタがパワーオンリセット状態に戻ります。このため、バッテリの挿入時に初期充電電流が7mAになります。

AlarmWarning()

AlarmWarning()コマンドは、Write-Wordプロトコルを使用します(図8a)。ChargingVoltage()のコマンドコードは0x16 (0b00010110)です。AlarmWarning()コマンドはALARM_INHIBITED状態ビットをセットします。MAX1667はOVER_CHARGED_ALARM (D15)、TERMINATE_CHARGE_ALARM (D14)及びOVER_TEMP_ALARM (D12)の3つの警報に応答します。表7に、AlarmWarning()コマンドの機能が説明されています。ALARM_INHIBITED状態ビットは、BATTER_PRESENT = 0(バッテリが外れた状態)又はPOR_RESETビットが設定された状態でChargeMode()が書き込まれるか、あるいは新しいChargingVoltage()又はChargingCurrent()が書き込まれるまでセットされたままです。

a) Write-Word Format

s	SLAVE ADDRESS	W	ACK	COMMAND BYTE	ACK	S	LOW DATA BYTE	ACK	HIGH DATA BYTE	ACK	Р
	7 bits	1b	1b	8 bits	1b		7 bits	1b	8 bits	1b	
	MSB LSB	0		MSB LSB			MSB LSB		MSB LSB		

Preset to 0b0001001 ChargerMode() = 0x12ChargingCurrent() = 0x14

AlarmWarning() = 0x16

ChargerVoltage() = 0x15

D7

b) Read-Word Format

S	SLAVE ADDRESS	W	ACK	COMMAND BYTE	ACK	S	SLAVE ADDRESS	R	ACK	LOW DATA BYTE	ACK	HIGH DATA BYTE	NACK	Р
	7 bits	1b	1b	8 bits	1b		7 bits	1b	1b	8 bits	1b	8 bits	1b	
	MSB LSB	0		MSB LSB			MSB LSB	1		MSB LSB		MSB LSB		
	Procet to			ChargorStatu	2() -		Procet to			D7 D0	•	D15 D8		

D0

D15

D8

Preset to ChargerStatus() = 0b0001001 0b0001001 0x13

Legend:

S = Start Condition or Repeated Start Condition

ACK = Acknowledge (logic low)

 \overline{W} = Write Bit (logic low)

P = Stop Condition

NACK = NOT Acknowledge (logic high)

R = Read Bit (logic high)

MASTER TO SLAVE SLAVE TO MASTER

図8. SMBusのa) Write-Word及びb) Read-Wordプロトコル

ChargerStatus()

ChargerStatus()コマンドは、Read-Wordプロトコルを 使用します(図8b)。ChargerStatus()のコマンドコード は0x13 (0b00010011)です。ChargerStatus()コマンド は、サーミスタインピーダンス及びMAX1667の内部 状態に関する情報を返します。Read-Wordプロトコル は、D15~D0を返します。表8には、個々のビットの 意味が説明されています。ラッチされたビット (THERMISTOR_HOT及びALARM_INHIBITED)は、 BATTERY_PERSENT = 0 になるか、POR_RESET ビット=1でChargeMode()が書き込まれるとクリア されます。

割込及びAlert-Responseアドレス

DCINに電源が投入されるか、BATTERY PRESENT ビットが変化するか、あるいはPOWER_FAILビットが 変化すると、割込がトリガされます(INTがローになり ます)。BATTERY_PRESENT及びPOWER_FAILは、 ChargeMode()コマンドを通じてセット/クリアできる 割込マスクを持っています。INTは、割込がクリアされ

るまでローに留まります。割込をクリアする方法には 2つありますが、1つはChargerStatus()コマンドの 発生による方法で、もう1つは0x19(0b0011001) Alert-ResponseアドレスでReceive Byteプロトコルを 使用する方法です。MAX1667は、自分のアドレス (0x13)を返されるバイトの最上位ビットとして残して Alert-Responseアドレスに応答します。

アプリケーション情報

負入力電圧保護

殆どのポータブル機器では、バッテリを充電するため のDC電力が2心線の円筒電源ジャックを通じて入って きます。ユーザは、簡単にDC電源の極性を切り換える アダプタを付加する可能性があります。有極コンデンサ C6は、負電圧が印加されると破壊されます。図7の ダイオードD4がこれを防ぎます。

DC入力電源の逆極性保護が必要ない場合は、ダイオード D4を省略できます。これにより、ダイオードD4の電圧 降下による電力損失を排除できます。

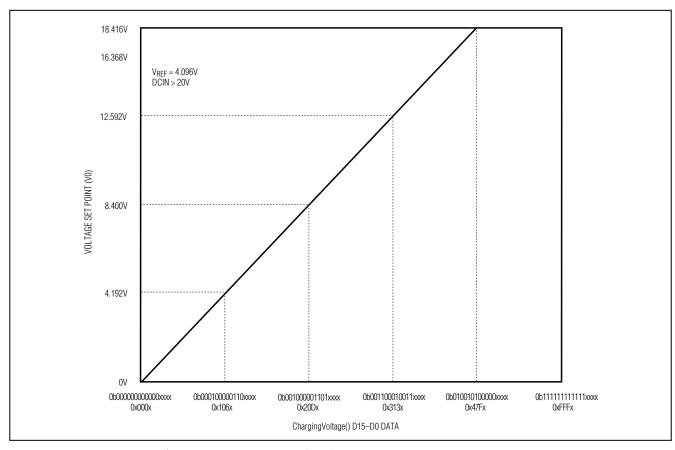


図9. ChargingVoltage()データから電圧へのマッピング

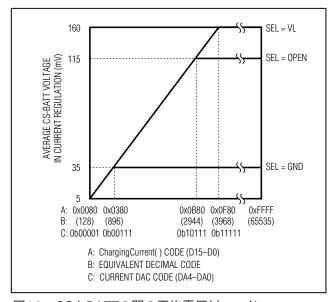


図10. CSとBATTの間の平均電圧対コード

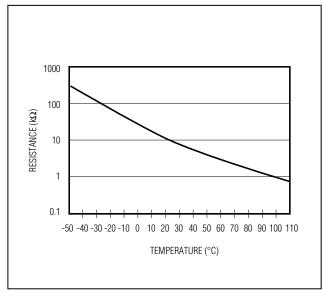


図11. 標準的なサーミスタ特性

あらゆるバッテリに対応した <u>レベル2スマー</u>トバッテリ充電器

表4. ChargingCurrent()ビットの機能

BIT POSITION	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FUNCTION	FUNCTION FS*					DA3	DA2	DA1	DA0		IOUT**					
WEIGHT IN mA (R _{SENSE} = 40m Ω)		390	68*		2048	1024	512	256	128				7**			

When SEL = VL, values above 0x0F80 set the output current to 3.968A.
When SEL = OPEN, values above 0x0B80 set the output current to 2.944A.
When SEL = GND, values above 0x0380 set the output current to 0.896A.

表5. IOUTソース電流とChargingCurrent()値の間の関係

CHARGE_ INHIBITED	(Note 1)	ALARM_ INHIBITED	ChargingVoltage()	ChargingCurrent()	CCV_LOW	VOLTAGE_ NOTREG	IOUT OUTPUT CURRENT (mA)
0	0	0	0x0000-0x000F	Х	Х	Х	0
0	0	0	X	0x0000	Х	Х	0
0	0	0	0x0010-0xFFFF	0x0001-0x0007	0	Х	7
0	0	0	0x0010-0xFFFF	0x0001-0x0007	1	0	0
0	0	0	0x0010-0xFFFF	0x0001-0x0007	1	1	7
0	0	0	0x0010-0xFFFF	0x0008-0x007F	0	Х	7
0	0	0	0x0010-0xFFFF	0x0008-0x007F	1	0	0
0	0	0	0x0010-0xFFFF	0x0008-0x007F	1	1	7
0	0	0	x0x0010-0xFFFF	0x0080-0xFFFF	Х	Х	0
0	0	1	Х	Х	Х	Х	0
0	1	Х	Х	X	Х	Х	0
1	Х	Х	X	X	Х	Х	0

Note 1: THERMISTOR_HOT and HOT_STOP and NOT (THERMISTOR_UR).

サーミスタの特性測定

図11は、MAX1667と使用する103ETB型サーミスタ (+25 で公称10k 、精度 ±5%)の予想される電気的 挙動です。このグラフはこの推奨サーミスタの標準的 な特性です。

THERMISTOR_ORビットはサーミスタ値が100k を 超えるときのみにセットされます。これは、サーミスタ がオープンになっていることを示します。

THERMISTOR_COLDビットはサーミスタ値が30k を超えるときのみにセットされます。これは、バッテリが冷めていることを意味します。

THERMISTOR_HOTビットはサーミスタ値が3k を下回るときのみにセットされます。

THERMISTOR_URビットはサーミスタ値が500 を 下回るときのみにセットされます。

サーミスタの値によっては複数のビットがセットされる場合があります(例えば、サーミスタが450 の場合、THERMISTOR_HOTとTHERMISTOR_URの両方がセットされます。)二次的なフェイルセーフインジケータとしてサーミスタを必要としないバッテリパックの場合、サーミスタを固定抵抗で置き換えることができます。この場合、抵抗を操作して充電器に正しい動作をさせる役目はバッテリパックが果たさなければなりません

^{**} Values below 0x0080 set the output current to 7mA.

表6. 電流DACコードとChargingCurrent()値の間の関係

CHARGE_INHIBITED	(Note 1)	ALARM_INHIBITED	ChargingVoltage()	ChargingCurrent()	SEL = GND CURRENT DAC CODE	SEL = GND SW REG ON?	SEL = GND CURRENT_OR	SEL = OPEN CURRENT DAC CODE	SEL = OPEN SW REG ON?	SEL = OPEN CURRENT_OR	SEL = VL CURRENT DAC CODE	SEL=VL SW REGON?	SEL=VL CURRENT_OR
0	0	0	0x0000-0x000F	X	N/A	No	0	N/A	No	0	N/A	No	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0000-0x007F	0	No	0	0	No	0	0	No	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0080-0x00FF	1	Yes	0	1	Yes	0	1	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0100-0x037F	2–6	Yes	0	2–6	Yes	0	2–6	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0380-0x03FF	7	Yes	0	7	Yes	0	7	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0400-0x047F	7	Yes	1	8	Yes	0	8	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0480-0x0B7F	7	Yes	1	9–22	Yes	0	9–22	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0B80-0x0BFF	7	Yes	1	23	Yes	0	23	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0C00-0x0C7F	7	Yes	1	23	Yes	1	24	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0C80	7	Yes	1	23	Yes	1	25–30	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x0F80-0x0FFF	7	Yes	1	23	Yes	1	31	Yes	0
0	0	0	0x000F-0xFFFF	0x1000-0xFFFF	7	Yes	1	23	Yes	1	31	Yes	1
0	0	1	Х	Х	N/A	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	No	N/A
0	1	Х	Х	Х	N/A	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	No	N/A
1	Х	Х	Х	X	N/A	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	No	N/A

Note 1: THERMISTOR_HOT and HOT_STOP and NOT (THERMISTOR_UR).

表7. AlarmWarning()コマンドの効果

	AlarmWarning() DATA BITS														RESULT	
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	RESOLI
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Set ALARM_INHIBITED
Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Set ALARM_INHIBITED
X	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Set ALARM_INHIBITED

表8. ChargerStatus()ビットの説明

NAME	BIT POSITION	LATCHED?	DESCRIPTION
CHARGE_INHIBITED	0	Yes	0 = Ready to charge a smart battery 1 = Charger is off; IOUT current = 0mA; DLO = PGND; DHI = LX
MASTER_MODE	1	N/A	Always returns '0'
VOLTAGE_NOTREG	2	No	0 = BATT voltage is limited at the voltage set point (BATT = V0). 1 = BATT voltage is less than the voltage set point (BATT < V0).
CURRENT_NOTREG	3	No	0 = Current through R1 is at its limit (I _{BATT} = I0). 1 = Current through R1 is less than its limit (I _{BATT} < I0).
LEVEL_2	4	N/A	Always returns 1
LEVEL_3	5	N/A	Always returns 0
CURRENT_OR	6	No	0 = ChargingCurrent() value is valid for MAX1667. 1 = ChargingCurrent() value exceeds what MAX1667 can actually deliver.
VOLTAGE_OR	7	No	0 = ChargingVoltage() value is valid for MAX1667. 1 = ChargingVoltage() value exceeds what MAX1667 can actually deliver.
THERMISTOR_OR	8	No	0 = THM voltage < 91% of REF voltage 1 = THM voltage > 91% of REF voltage
THERMISTOR_COLD	9	No	0 = THM voltage < 75% of REF voltage 1 = THM voltage > 75% of REF voltage
THERMISTOR_HOT	10	Yes	This bit reports the state of an internal SR flip-flop (denoted THERMISTOR_HOT flip-flop). The THERMISTOR_HOT flip-flop is set whenever THM is below 23% of REF. It is cleared whenever BATTERY_PRESENT = 0 or ChargerMode() is written with POR_RESET = 1.
THERMISTOR_UR	11	No	0 = THM voltage > 5% of REF voltage 1 = THM voltage < 5% of REF voltage
ALARM_INHIBITED	12	Yes	This bit reports the state of an internal SR flip-flop (denoted ALARM_INHIBITED flip-flop). The ALARM_INHIBITED flip-flop is set whenever the AlarmWarning() command is written with D15, D14, or D12 set. The ALARM_INHIBITED flip-flop is cleared whenever BATTERY_PRESENT = 0, or ChargerMode() is written with POR_RESET = 1, or ChargingVoltage() or ChargingCurrent() is written.
POWER_FAIL	13	No	0 = BATT voltage < 89% of DCIN voltage 1 = BATT voltage > 89% of DCIN voltage
BATTERY_PRESENT	14	No	0 = No battery is present (THERMISTOR_OR = 1). 1 = A battery is present (THERMISTOR_OR = 0).
AC_PRESENT	15	No	0 = VL voltage < 4V 1 = VL voltage > 4V

^{*}Bit position in the D15-D0 data

N/A = Not applicable

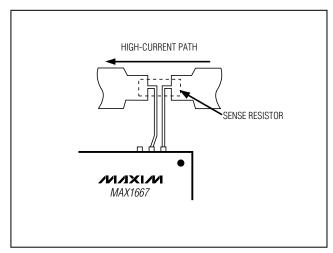


図12. 電流検出抵抗用のケルビン接続

プリント基板レイアウト上の考慮

仕様のノイズ、効率及び安定動作を実現するには、良好なプリント基板レイアウトが必要です。プリント基板レイアウト作成者には、パワースイッチング部品及び大電流配線の配置を示す鉛筆描きのスケッチ等、明確な指示を与える必要があります。MAX1667評価キットのマニュアルにプリント基板レイアウトの例があります。最適の性能を得るにはグランドプレーンが必須です。殆どのアプリケーションにおいては、回路は複層基板上に配置されるますが、4層以上の銅層を十分に活用することを推奨します。最上層は大電流接続に、最下層は低電流接続(REF、CCV、CCI、DACV及びGND)に使用して下さい。中間層は切れ目のないグランドプレーンとして使用して下さい。以下の手順に従って下さい。

- 1) 大電力部品(C1、C6、M1、M2、D1、L1及びR1) を最初に配置します。その際、これらの部品の グランド同士を隣接させます。
 - 電流検出抵抗のトレース長をできるだけ短くし、 電流を正確に検出するためにケルビン接続にし ます(図12)。
 - 大電流経路のグランドトレースをできるだけ短く します。
 - 大電流経路のその他のトレースをできるだけ短く します。
 - -- トレースの幅を5mm以上にして下さい。
 - -- CINからハイサイドMOSFETのドレインまでの 長さは最大10mmです。
 - -- 整流器ダイオードのカソードからローサイドに 接続します。
 - -- MOSFETまでの長さは最大5mmです。
 - -- LXノード(MOSFET、整流器カソード、インダクタ) の長さは最大15mmです。

表面実装電力部品同士が接触し合って、各グランド端子同士が殆ど触れ合っている形が理想的です。これらの大電流グランドは、ビアを通さないで最上層の銅の広い隙間のないゾーンで互いに接続します。こうしてできた最上層の「サブグランドプレーン」は、出力グランド端子のところで通常の内層のグランドプレーンに接続します。これにより、ICのアナロググランドがIRドロップやグランドノイズの影響なしに電源の出力端子で検出できるようになります。その他の大電流経路もできるだけ短くすべきですが、主にグランドや電流検出線の接続の短縮に努力を集中することにより、プリント基板のレイアウトの問題の約90%までは解決されます。

- 2) IC及び信号部品を配置します。メインスイッチング ノード(LXノード)を敏感なアナログ部品(電流検出 トレース及びREFコンデンサ)から遠ざけて下さい。 IC及びアナログ部品は、基板上のパワースイッチング ノードの反対面に配置します。重要:ICは電流検出 抵抗から10mm以内に配置する必要があります。 ゲート駆動トレース(DH、DL及びBST)は、20mm 以内に短く保ち、CSH、CSL及びREFから遠ざけて 配線して下さい。セラミックバイパスコンデンサは、 ICの近くに配置して下さい。バルクコンデンサは、 これより遠くても構いません。
- 3) 入力グランドトレース、パワーグランド(サブグランド プレーン)及び通常グランドプレーンが電源の出力 グランド端子で出会うところで、シングルポイント・スターグランドにします。ICの両方のグランドピン 及び全てのICバイパスコンデンサを、通常グランド プレーンに接続します。

MAX1647からMAX1667へのアップグレード

MAX1667はMAX1647とピン配置及びソフトウェアが コンパチブルなアップグレード製品となっています。 機能的には以下の違いがあります。

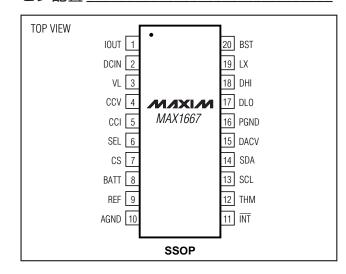
- 1) PWMデューティサイクルが97%まで拡張されました。
- 2) 内部リファレンスが+4.096V(精度はライン、負荷 及び温度の全範囲にわたって1%)に変わりました。
- 3) 内部電圧DACが変更されて、最大18.416mVまで 設定できるようになりました。最大4セルのLi+電池 が充電可能です。
- 4) リニア電流ソース(IOUT)は7mAまで低減され、スイッチングレギュレータがオンの時はターンオフされるようになりました。
- 5) DC電源が除去された時にBATTから逆電流が流れる のを防ぐために、IOUTピンに内部ダイオードが追加 されました。
- 6) 内部電流DACの分解能が6ビットから5ビットに変更 されました。

- 7) SELピンを使って、検出抵抗の値を変えずに出力 電流のリミットをディジタルで4A、3A又は1Aに 設定できるようになっています。
- 8) シングルカウント電流検出電圧が5mVに変更されました。必要なR1は40m になりました。
- 9) AlarmWarning()の後で充電器がオフ状態にロックされません。MAX1667はその後でCharging Voltage()又はChargingCurrent()コマンドを使用して充電を再開できます。
- 10) Alert-Responseアドレスは0x13 (0b00010011) です。

MAX1647を使った設計をグレードアップする場合は、 以下の変更点に従って下さい(部品番号はMAX1647 データシートの図3をご覧下さい)。

- 1) R1を40m に変更します(必須項目)。
- 2) ダイオードD5及びD6、トランジスタQ1及び抵抗 R6を外します。IOUTを直接BATTに接続します (推奨項目)。
- 3) 外部+4.096Vリファレンスを取り外します(推奨項目)。
- 4) D6を取り外します(推奨項目)。この時R7と直列 に小信号ダイオードを取り付け、それをDC電源に 直接接続します(MAX1647データシートのD3及び R5を参照)。

ピン配置

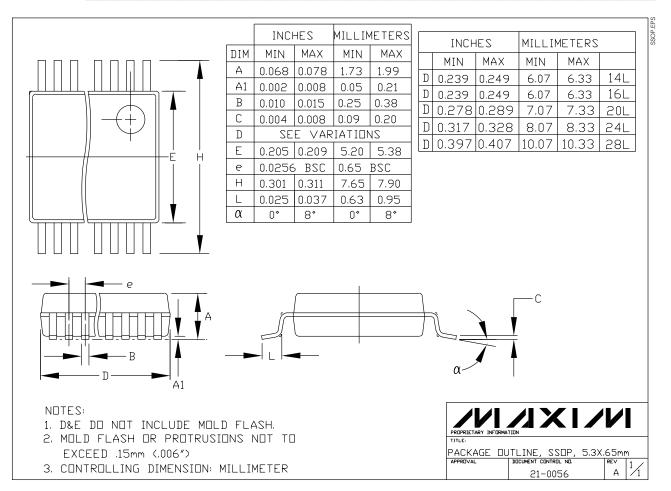


チップ情報

TRANSISTOR COUNT: 6378

SUBSTRATE CONNECTED TO AGND

パッケージ _____



NOTES

NOTES

販売代理店	

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル) TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシム社は随時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

28 ______Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 (408) 737-7600